삼성전자, 시안에 낸드플래시 건설

2012년 건설 착수해 2013년 말 상업가동 … 10나노급 중국시장 선점

중국 반도체 공장 건설을 추진하고 있는 삼성전자가 산시(陝西)성 시안(西安)시를 우선협상 도시로 선정했다.

삼성전자는 3월21일 차세대 낸드플래시 생산라인을 건설하기 위해 시안시와 양해각서(MOU) 체결을 위한 실무협상을 시작한다고 발표했다.

삼성의 해외 반도체 공장 건설은 1996년 미국 오스틴에 이어 2번째로, 삼성전자는 2011년 12월 반도체 중국공장 건설을 지식경제부에 신청해 2012년 1월 승인받았다.

삼성전자는 시안시와 협상이 원만하게 마무리되고 중국 정부의 승인절차가 완료되면 2012년 건설에 착수해 2013년 말부터 생산라인 가동에 들어갈 계획이다.

시안시는 산업용수, 전기 등 반도체 라인 운영에 필요한 산업 인프라가 잘 갖추어져 있고 많은 IT(정보기술)기업의 연구거점과 유수의 대학들이 소재해 우수 인재를 확보할 수 있는 이점이 있는 것으로 알려졌다.

특히, 시안을 포함한 중국 서부는 글로벌 IT기업들이 생산거점으로 속속 진출하고 있고, 중국 수요처들이 지속적으로 확대되고 있어 신속한 시장 트렌드 반영과 고객 대응이 가능한 전략거점으로 기대되고 있다.

삼성전자는 2012년 고성능 대용량 10나노급 낸드플래시를 양산해 프리미엄 메모리 시장을 주도하고 있으며, 2012년부터 중국에서도 10나노급 낸드플래시 양산을 개시해 중국시장을 선점할 계획이다. <저작권자 연합뉴스 - 무단전재 · 재배포 금지>

<화학저널 2012/03/22>